

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально планарные полевые с каналом п-типа транзисторы с диффузионным затвором.

Климатическое исполнение — УХЛ

Схема расположения выводов



Масса не более 0,5 г.

Содержание драгоценных металлов в одном изделии;
золото — 0,0090283 г.

Основные электрические параметры при температуре $(+25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Типы транзисторов	Ток утечки затвора, мкА ($U_{зи} = 0$; $U_{зи} = -30\text{В}$)		Ток утечки затвора, нА ($U_{зи} = 0$; $U_{зи} = -10\text{В}$)		Начальный ток стока, мА ($U_{зи} = 10\text{В}$; $U_{зи} = 0$)		Напряжение отсечки, В ($U_{зи} = 10\text{В}$; $I_c = 10^{-3}$ мА)		Круглизна характеристики, мА/В ($U_{зи} = 10\text{В}$; $U_{зи} = 0$; $f = 50 \div 1500$ Гц)	ЭДС шума, мВ/√Гц ($U_{зи} = 10\text{В}$; $U_{зи} = 0$; $f = 103$ Гц)	ЭДС шума, мВ/√Гц ($U_{зи} = 10\text{В}$; $U_{зи} = 0$; $f = 10^5$ Гц)	Активная составляющая выходной проводимости, мкСм ($U_{зи} = 10\text{В}$; $U_{зи} = 0$; $f = 50 \div 1500$ Гц)	Коэффициент шума, дБ ($U_{зи} = 10\text{В}$; $I_c = 5\text{мА}$; $f = 4 \cdot 10^8$ Гц)	Входная емкость, пФ ($U_{зи} = 10\text{В}$; $f = 10^7$ Гц)	Проходная емкость, пФ ($U_{зи} = 10\text{В}$; $f = 10^7$ Гц)
	не более	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более							
2П307А	10	1	3	9	0,5	3	4	9	20	—	—	—	5	1,5	
2П307Б	10	1	5	15	1	5	5	10	—	2,5	—	6	5	1,5	
2П307Г	10	1	8	24	1,5	6	6	12	—	2,5	200	6	5	1,5	

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа 2П307А, 2П307Б, 2П307Г соответствуют ГОСТ В 22468-77 и техническим условиям 3.365.008 ТУ.

Приняты по извещению № 29 от 27.02.91

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК



МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКАЗЧИКА



Место для штампа «Перепроверка произведена» _____

Приняты по извещению № _____ от _____

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКАЗЧИКА